

真空紫外線処理を施した高分子樹脂と無電解めっき膜 密着性向上メカニズム解明のための密着界面評価

Evaluation of the Adhesion Interface for Clarifying the Mechanism of Improved Adhesion between Vacuum Ultraviolet-Treated Polymer Resins and Electroless Plating Films

ユーザー氏名 / User's Name :

有本太郎^{ab} / Taro Arimoto^{ab} (^aウシオ電機株式会社, ^b大阪大学 / ^aUSHIO INC, ^bOsaka University)

実施機関担当者 / Person in Charge of ARIM :

東嶺孝一, 小林祥子 / Koichi Higashimine, Shoko Kobayashi
(北陸先端科学技術大学院大学 / Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST))

KEY WORDS

Scanning transmission electron microscope, Electron energy loss spectroscopy, Interface, Excimer lamp, Surface modification, Vacuum Ultraviolet, PolymerOxidized layer, Electroless copper plating



概要 / Overview

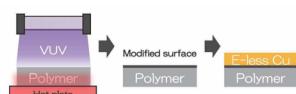
半導体の処理能力を向上させるための取り組みとして、半導体チップを高密度に実装する先端半導体パッケージング技術が注目されている。パッケージ基板の高速伝送化・微細配線化には、配線／基板界面の平滑性を維持したまま、密着性を確保することが必要となっている。我々は、エキシマVUV ($\lambda=172\text{ nm}$)処理を用いた表面改質に取り組んでおり、高分子樹脂基板表面へのVUV照射により基板表面の平滑性を維持したまま基板にCuめっき膜を密着させることに成功している。今回の研究では、VUV照射がめっき膜の密着強度に与える影響の要因を調べるために、透過電子顕微鏡により微視的な改質層および界面構造の観察・測定を実施し、その界面での密着メカニズムを明らかにした。

As part of an initiative to enhance the processing capabilities of semiconductors, advanced packaging technologies that enable high-density integration of semiconductor chips are gaining significant attention. To achieve high-speed transmission and fine wiring in package substrates, it is essential to ensure adhesion while maintaining the smoothness of the wiring/substrate interface. We are focused on surface modification using excimer VUV treatment, successfully achieving adhesion of Cu plating films to the surfaces of polymer resin substrates while preserving the smoothness of the substrate through VUV irradiation. In this study, we conducted observations and measurements of the microscopic interface structure using transmission electron microscopy to investigate the factors influencing the adhesion strength of the plating film due to VUV irradiation, thereby clarifying the adhesion mechanism at that interface.

エキシマVUV処理による表面改質への応用

Surface modification using excimer VUV treatment

● エキシマVUV処理の表面改質への利用



本研究でのVUV処理によるサンプル処理

これまでの紫外線に対するイメージ
紫外線は高分子材料を“劣化”させる要因
長時間照射による耐候性評価など
巨視的な特性変化の理解が中心



エキシマ照射装置(HPV-STシリーズ)

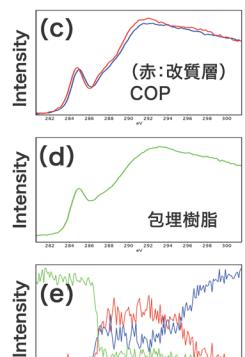
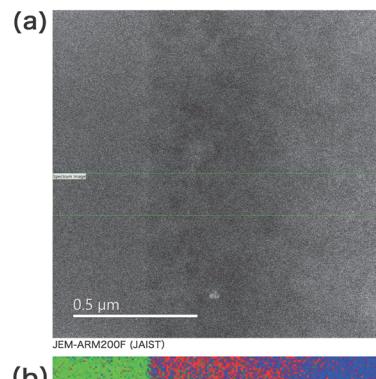
発想の転換

本研究での取り組み
短時間で処理可能な“表面改質”的手段
ナノスケールでの現象解析と
現象把握による表面・界面制御

STEM-EELS-SI 測定への多変量解析プログラム適用

Application of multivariate analysis programs to STEM-EELS-SI measurements

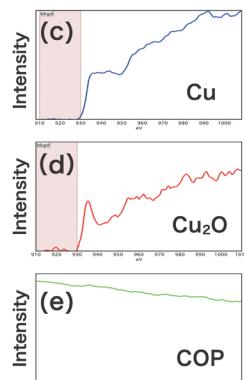
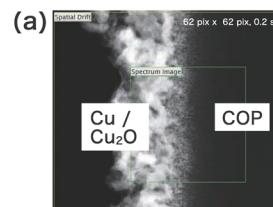
● EELSを用いた加熱VUV処理による改質層の可視化に成功



VUV照射COPのEELS-SI測定と多変量解析の結果

(a)survey image, (b)分布図, (c)COP領域, (d)包埋樹脂領域, (e)(b)の積算ラインプロファイル

● 樹脂金属界面の可視化による密着メカニズムの解明



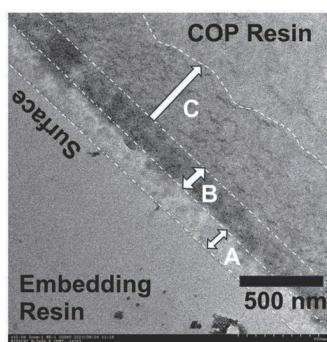
Cu-COP界面のEELS-SI測定と多変量解析の結果

(a)survey image, (b)分布図, (c)Cu領域, (d) Cu₂O領域, (e)COP領域. (c)(d)はバックグラウンドを除去

染色TEM断面観察によるエキシマVUV改質層の可視化

Visualization of excimer VUV modified layers through stained TEM cross-sectional observation

● 加熱VUV処理による改質層の明確化



VUV処理により表面改質したサンプルをヨウ素イオン染色し、TEM像を得る
 $KI + I_2 \leftrightarrow K^+ + I_3^-$



改質層が多層構造を形成していることを確認

A層 : COP表面(0nm)から150nmの深さ領域でやや明るい領域と、やや暗い領域とが混在している。

B層 : COP表面から150nm～300nmの深さ領域で暗い領域が存在している。

C層 : COP表面から300nm～700nmの深さ領域で筋状(直鎖状)のやや暗いコントラストが存在している。

ヨウ素イオン染色法により染色したCOP試料の断面観察像

CONTACT

ユーザー：有本太郎, ウシオ電機株式会社/Taro Arimoto, USHIO INC.,

実施機関：東嶺孝一, 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター解析技術グループ/Koichi Higashimine, JAIST

